



Электричество и магнетизм

Лекция 06

Проводники. Конденсаторы.
Энергия электрического поля

06 октября 2021 года
Лектор: доцент НИЯУ МИФИ,
Ольчак Андрей Станиславович



Проводники и диэлектрики



Диэлектрик – вещество, где нет свободных электрических зарядов, способных перемещаться под действием приложенного электрического поля (= проводить электрический ток).

Проводник – вещество, где способные перемещаться заряды есть и электрический ток (упорядоченное направленное движение электрических зарядов) существовать может .



Характеристики диэлектриков



Вектор поляризованности – дипольный момент единицы объема поляризованного вещества

$$\vec{\mathbf{P}} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \vec{\mathbf{p}}_i$$

В изотропном диэлектрике $\mathbf{P} = \varepsilon_0 \xi \mathbf{E}$

$\xi = \varepsilon - 1$ – диэлектрическая восприимчивость

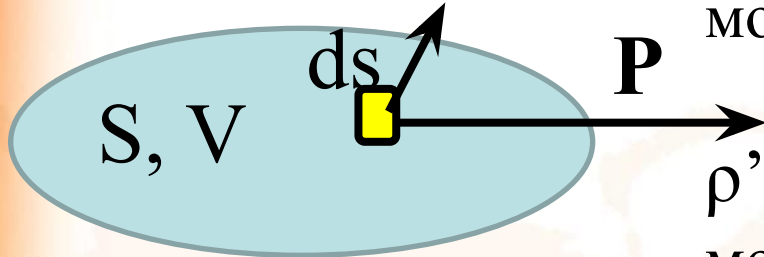
$\varepsilon = 1 + \xi$ – диэлектрическая проницаемость

Вектор электрической индукции в однородном диэлектрике

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \varepsilon \mathbf{E}$$



$$\sigma = (\mathbf{P}, \mathbf{n})$$



ρ, q – сторонний заряд (не принадлежит молекулам диэлектрика)

ρ', q' = связанный заряд (принадлежит молекулам диэлектрика)

$$\operatorname{div} \mathbf{P} = -\rho'$$

$$\oint (\mathbf{P}, d\mathbf{S}) = q'$$

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho$$

$$\boxed{\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q}$$

$$\varepsilon_0 \operatorname{div} \mathbf{E} = \rho + \rho'$$

$$\oint (\mathbf{E}, d\mathbf{S}) = q + q'$$



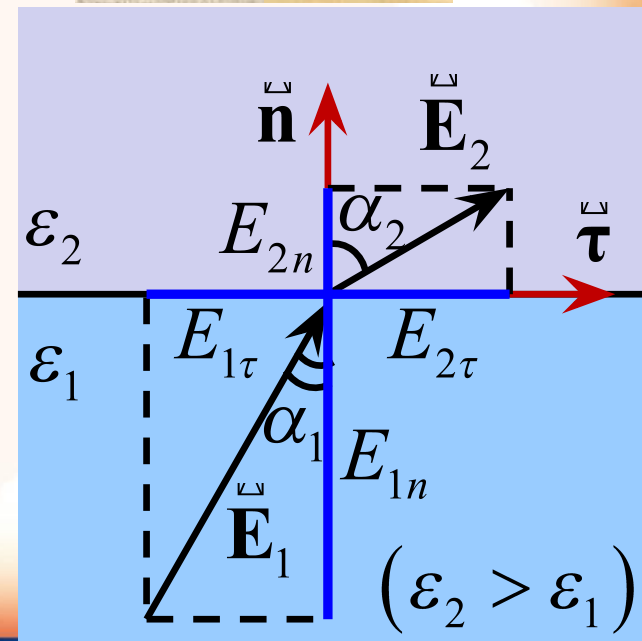
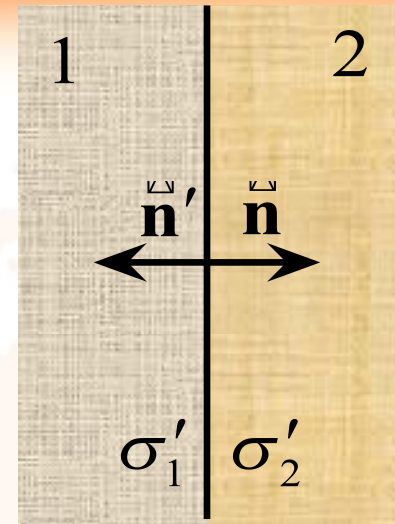
Связанные заряды на границе двух диэлектриков

$$\sigma = (\mathbf{P}, \mathbf{n}) \Rightarrow \boxed{\sigma' = P_{1n} - P_{2n}}$$

$$D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau} \Rightarrow \frac{D_{1\tau}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2\tau}}{\varepsilon_2}$$

$$\boxed{\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$$





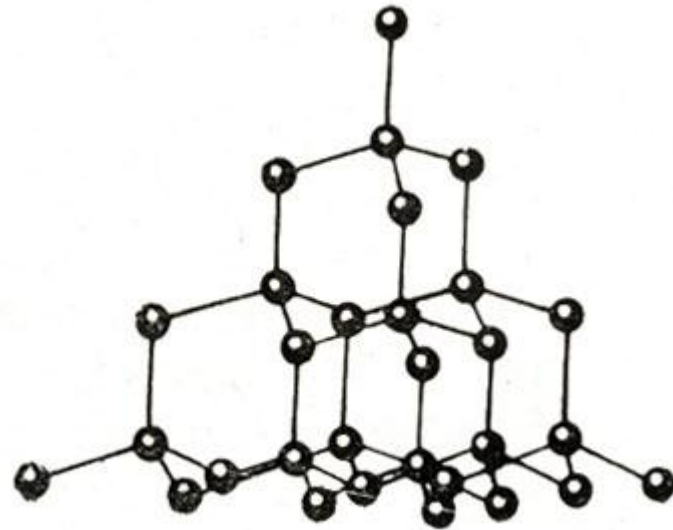
$$P_i = \varepsilon_0 \sum_{j=1}^3 \xi_{ij} E_j, \quad i, j = x, y, z.$$

$$D_i = \varepsilon_0 \sum_{j=1}^3 \varepsilon_{ij} E_j$$

$$\varepsilon_{ij} = \delta_{ij} + \xi_{ij}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Кристаллическая
решетка алмаза





Кристаллические диэлектрики



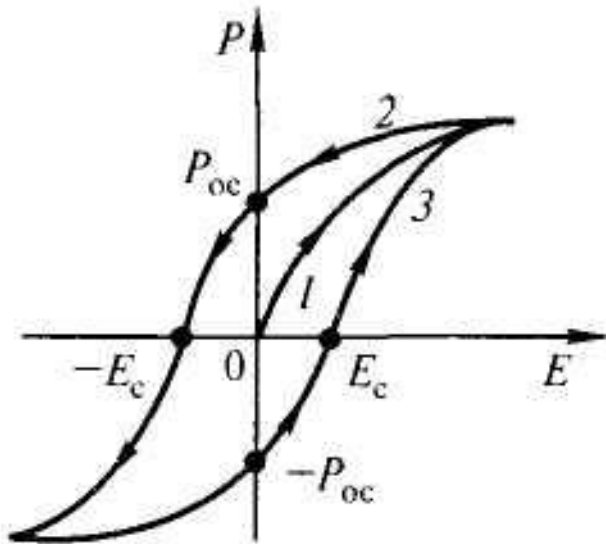
Пьезоэлектрики – кристаллические диэлектрики, в которых при сжатии и растяжении в определённых направлениях возникает электрическая поляризация в отсутствие электрического поля (прямой пьезоэффект)

Пироэлектрики – кристаллические диэлектрики, обладающие спонтанной поляризацией (в отсутствие электрического поля), которая изменяется при изменении температуры.

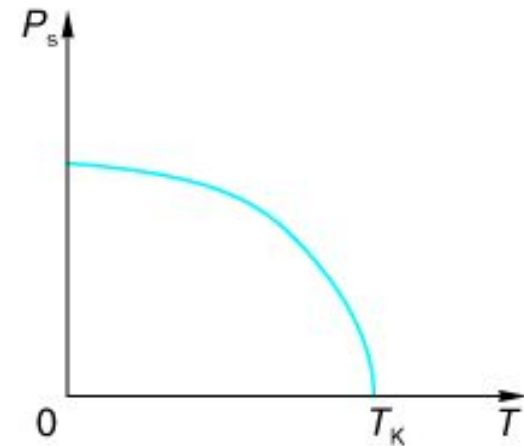
Сегнетоэлектрики – кристаллические диэлектрики, обладающие в определённом интервале температур спонтанной поляризацией, которая существенно изменяется при внешних воздействиях.



$$\varepsilon \sim 10^3 - 10^4$$



Зависимость поляризованности от напряжённости электрического поля в сегнетоэлектрике.



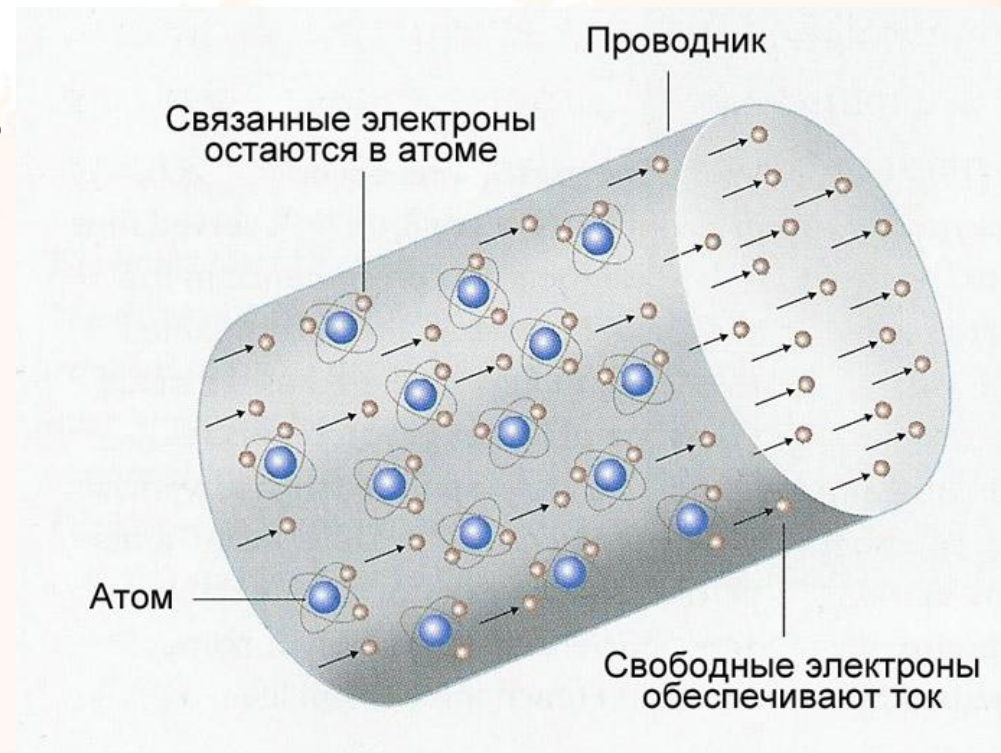
Зависимость спонтанной поляризации от температуры.
 T_k – температура Кюри

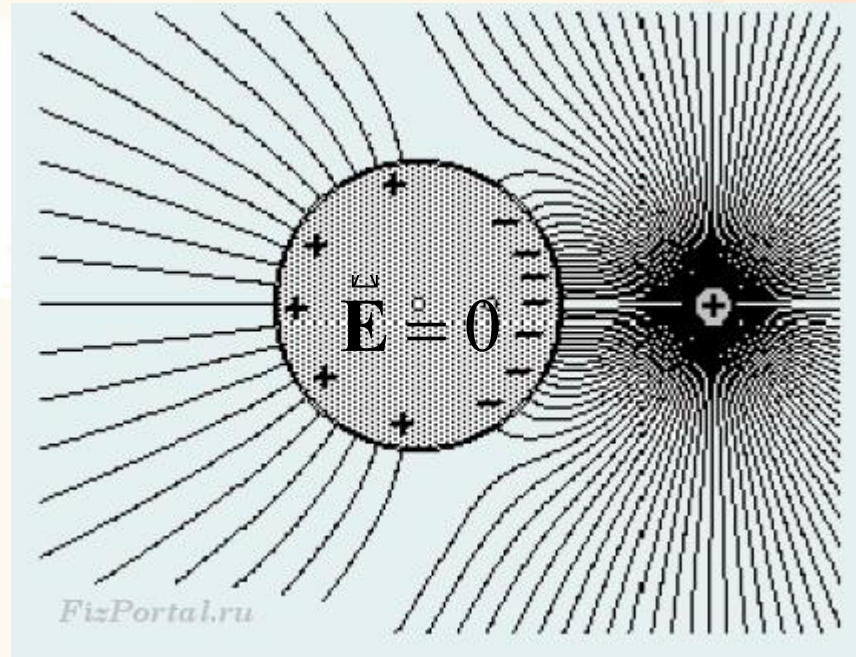
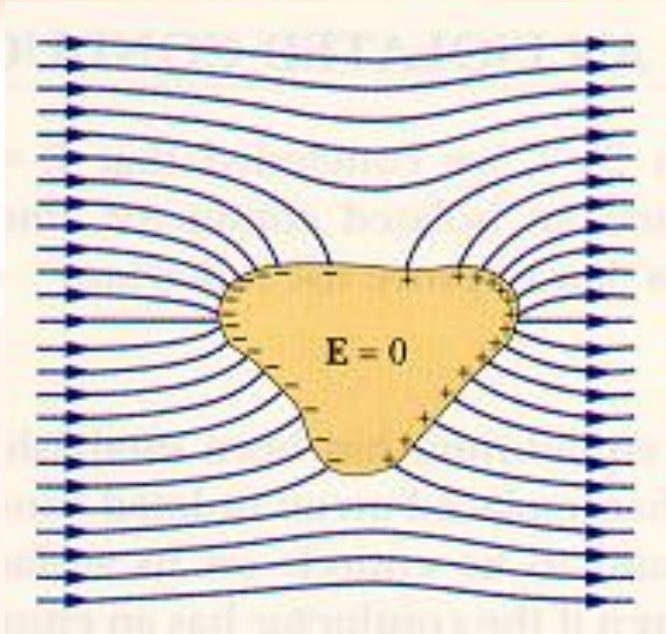


Проводники в электрическом поле

Проводник – это вещество хорошо проводящее электрический ток.

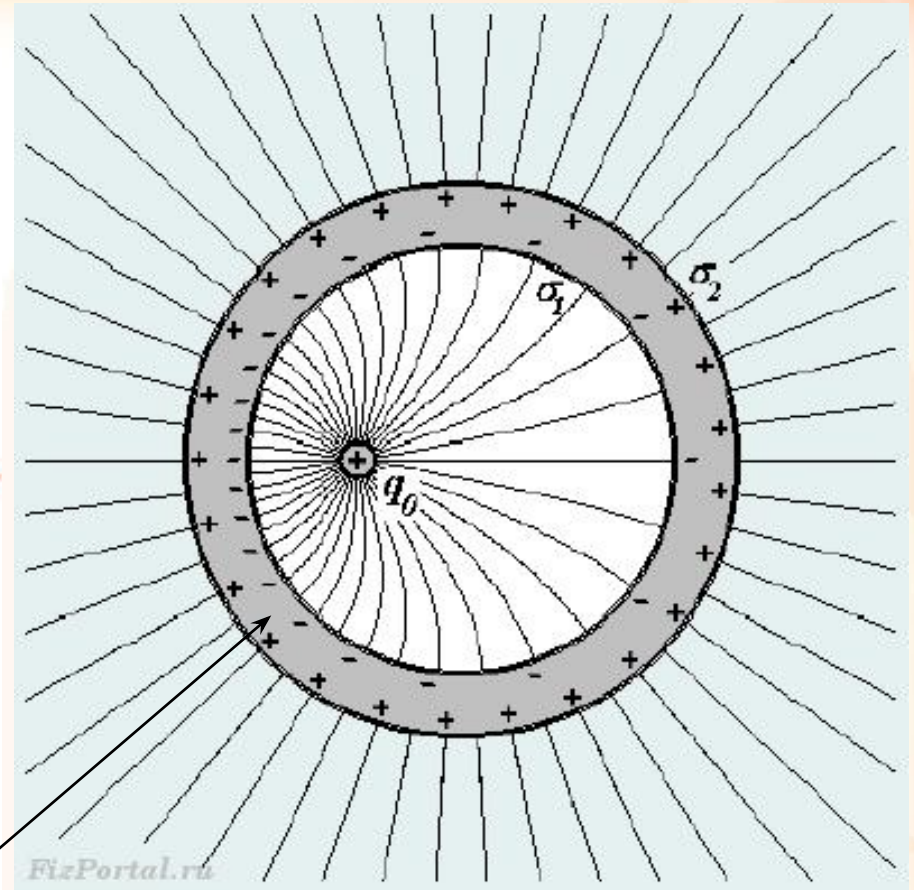
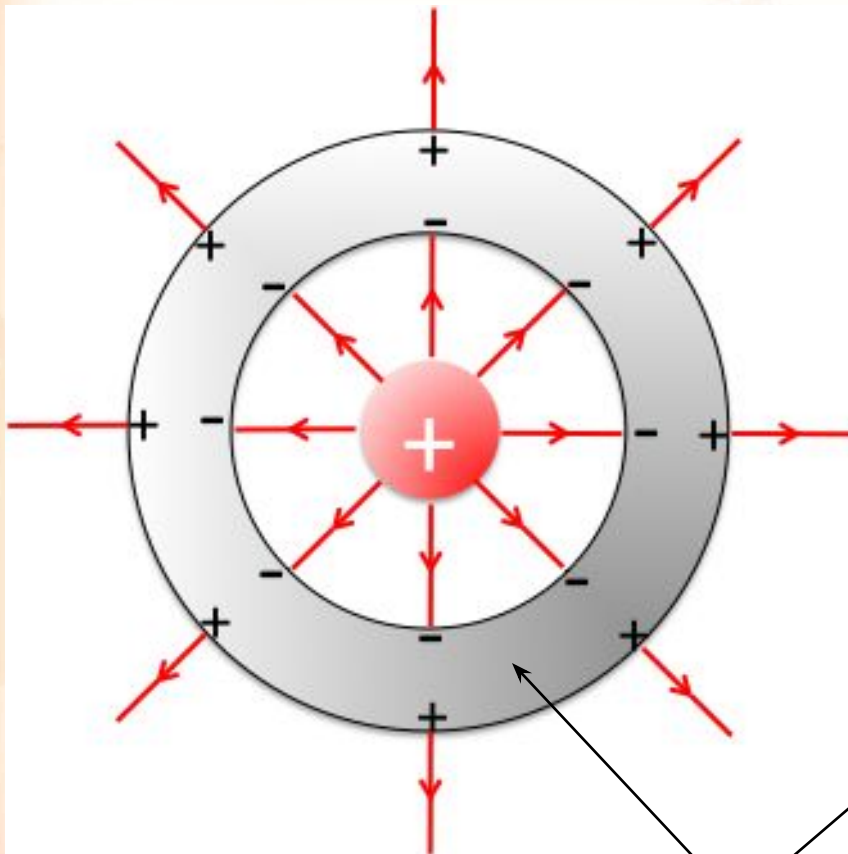
В проводнике есть свободные электрические заряды.



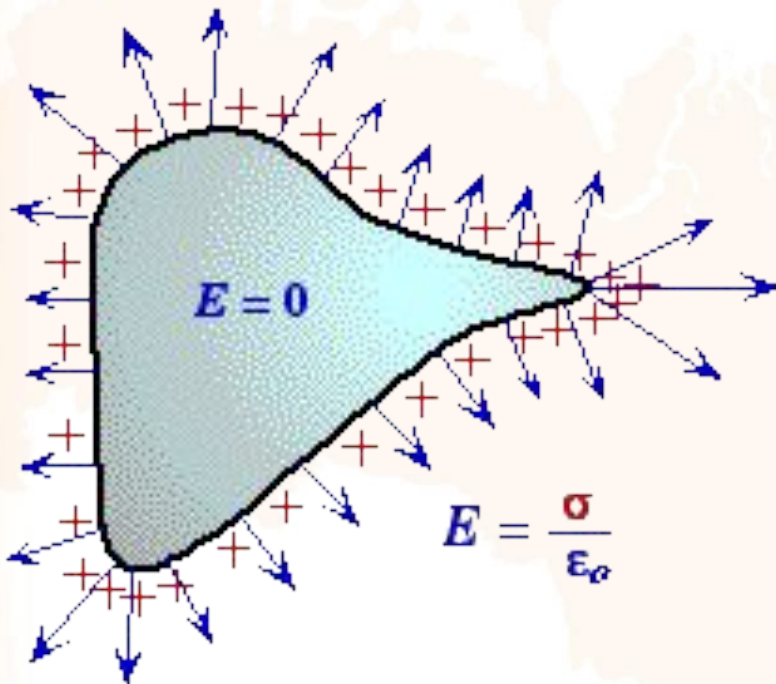


$$\vec{E} = 0 \quad \vec{E} = -\nabla\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const}$$
$$(\nabla, \vec{E}) = \rho/\varepsilon_0 = 0 \Rightarrow \rho = 0$$

Свободные заряды в проводнике перераспределяются так, что внутри проводника напряженность поля равна 0, а на поверхности – перпендикулярна таковой.



$$\vec{E} = 0$$

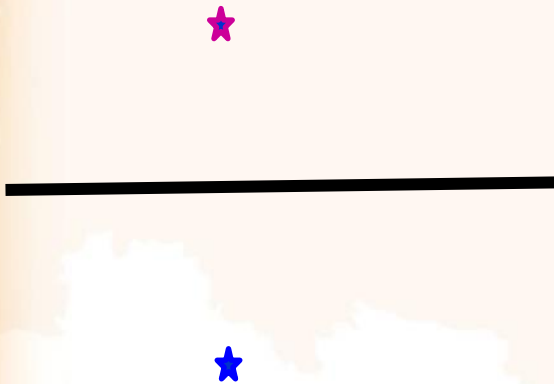


- 1) Свободные заряды располагаются на поверхности проводника
- 2) Внутри проводника $\vec{E} = 0$, $\varphi = \text{const}$, $\rho = 0$.
- 3) Снаружи проводника вектор \vec{E} ортогонален его поверхности, причём $E_n = \sigma / (\epsilon \epsilon_0)$, $E_\tau = 0$.



Принцип зеркала.

Пусть у проводящей поверхности располагается какой-то внешний заряд. Свободные заряды проводника распределятся по поверхности так, чтобы создать поле, эквивалентное тому, что создал бы заряд противоположного знака, помещенный в точку, где находилось бы зеркальное изображение внешнего заряда.. .



$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0}, \quad E_\tau = 0$$

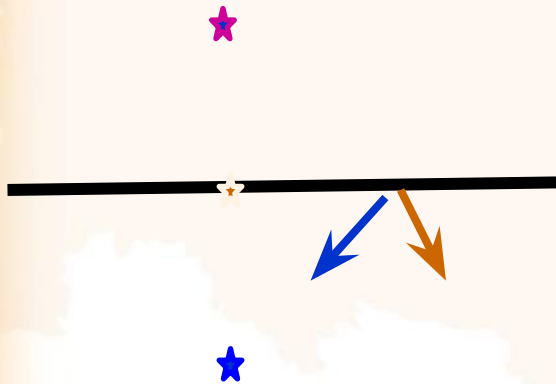


Пример: Заряд q находится на расстоянии a от проводящей плоской поверхности. Найти плотность поверхностного заряда на расстоянии r от точки проекции заряда q на плоскость. Найти потенциал этой плоскости.

$$E_n(r) = 2(kq/(r^2 + a^2))(a/(r^2 + a^2)^{1/2}) = \\ = 2kqa/(r^2 + a^2)^{3/2} = >$$

$$\sigma = -\varepsilon qa/2\pi(r^2 + a^2)^{3/2}$$

$$\varphi = 0$$



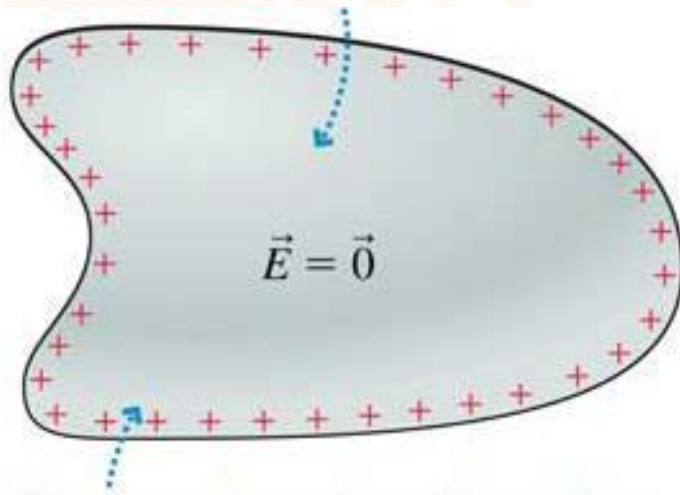
$$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}, \quad E_\tau = 0$$



Электроемкость проводника. Конденсаторы.

Опыт: $\varphi \sim q$

$$\varphi = \int_1^{\infty} \mathbf{E} d\mathbf{l}, \quad E \sim q \Rightarrow \varphi \sim q$$

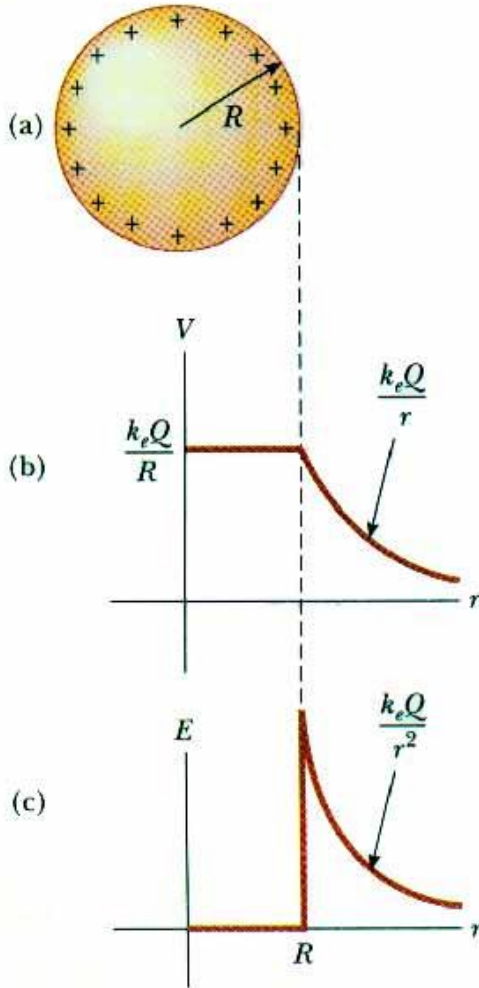


Ёлектроёмкостью уединённого проводника называется коэффициент пропорциональности между зарядом и потенциалом проводника

$$q = C\varphi$$

$$C = \frac{q}{\varphi}, \quad \Phi = \frac{\text{Кл}}{\text{В}}$$

Ёмкость проводника зависит от его размеров и формы, но не зависит ни от заряда, ни от потенциала проводника.



Ёмкость шара

$$\varphi(R) = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} = \frac{q}{C} \Rightarrow$$

$$C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$$

$$R_3 = 6,4 \cdot 10^6 \Rightarrow$$

$$C = \frac{6,4 \cdot 10^6}{9 \cdot 10^9} \approx 0,7$$



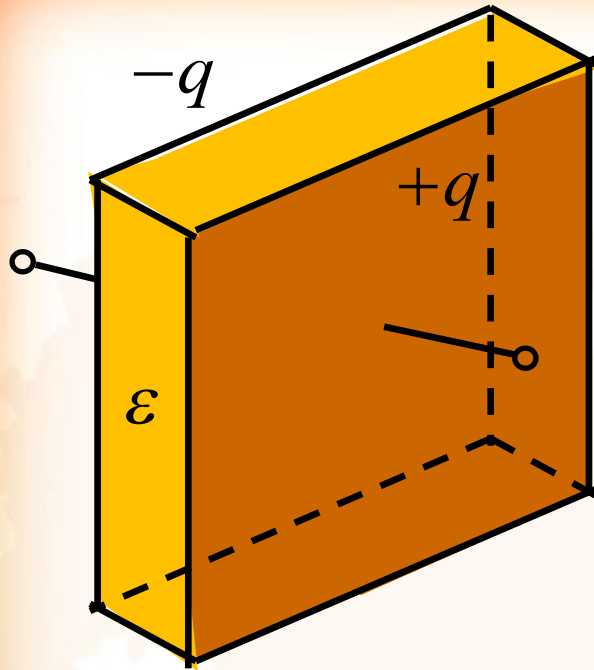
Электрическая ёмкость конденсатора

Электрическим конденсатором называют совокупность двух проводников, заряженных одинаковыми по модулю и противоположными по знаку зарядами.

$$\text{Опыт: } q \sim U = \varphi_1 - \varphi_2$$

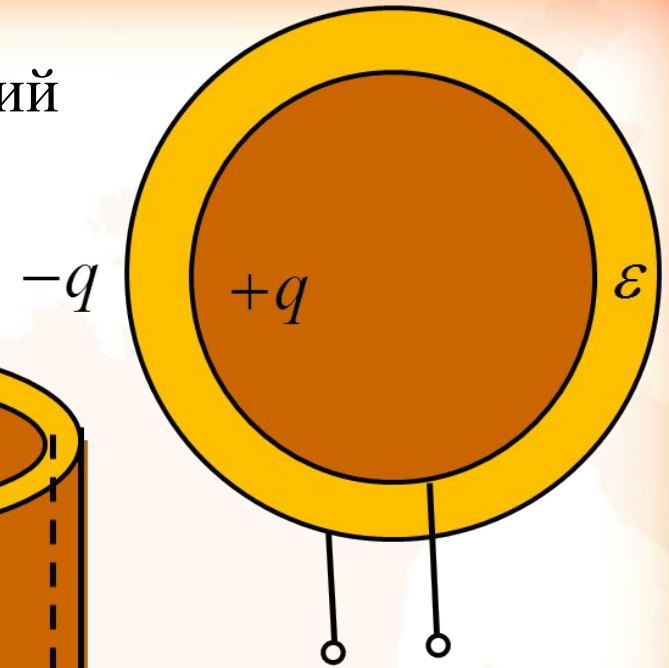
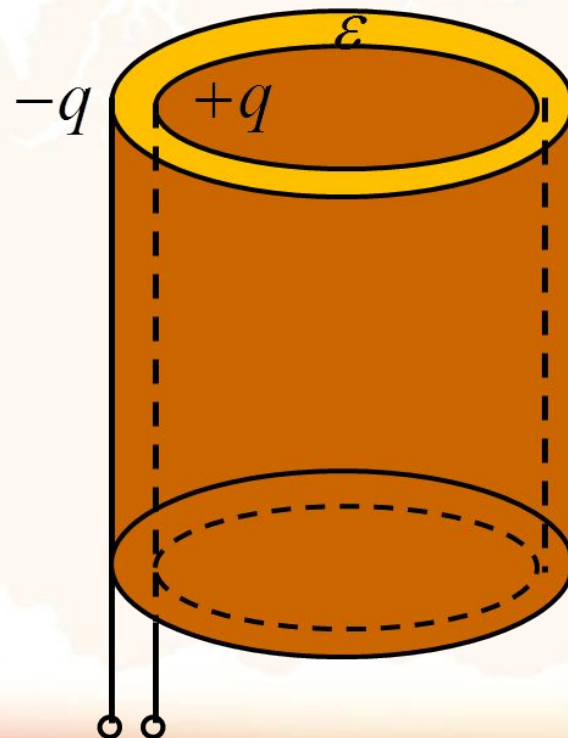
Электрической ёмкостью конденсатора называют коэффициент пропорциональности между зарядом обкладок и напряжением на конденсаторе.

$$\boxed{q = CU} \Rightarrow C = \frac{q}{U}, \Phi = \frac{\text{Кл}}{\text{В}}$$



Плоский
конденсатор

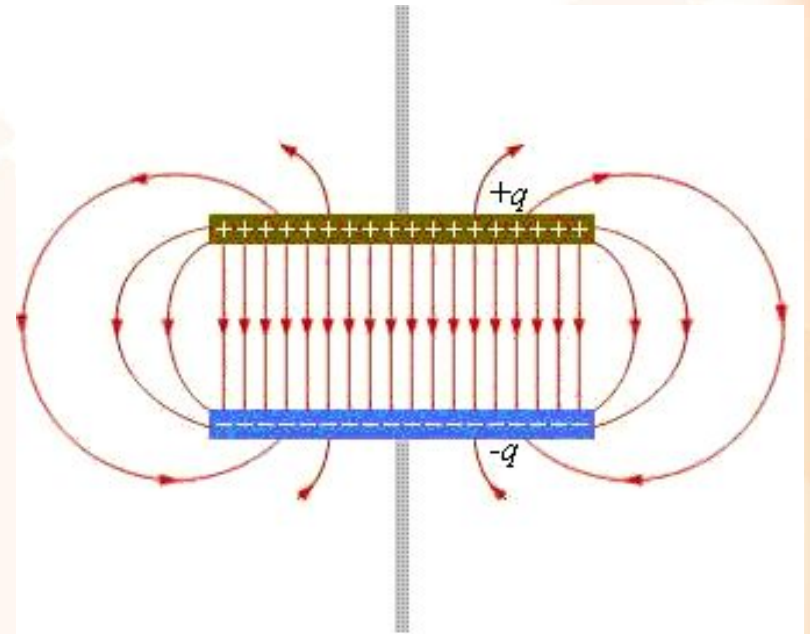
Цилиндрический
конденсатор



Сферический
конденсатор

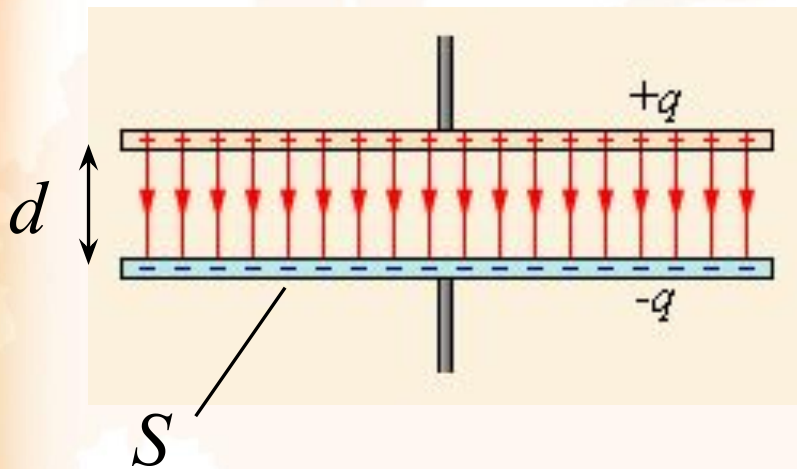
Ёмкость конденсатора зависит от формы и размеров обкладок, расстояния между ними и вида диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками.

Ёмкость конденсатора не зависит ни от заряда, ни от напряжения на конденсаторе.



Линии напряжённости реального конденсатора

Ёмкость плоского конденсатора



$$\sigma = \frac{q}{S} \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon\epsilon_0} =$$

$$= \frac{qd}{\epsilon\epsilon_0 S} = \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{\epsilon\epsilon_0 S} = \frac{1}{C} \Rightarrow$$

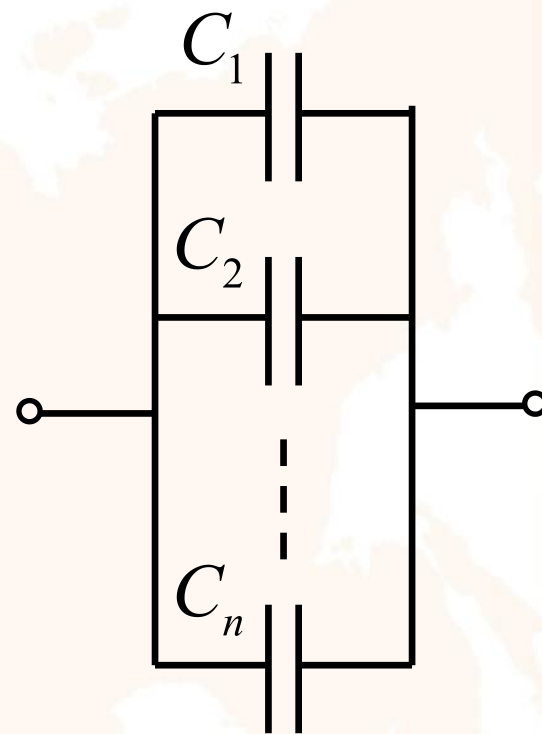
$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}$$



Ёмкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов



$$\frac{1}{C_{\text{общ}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$



$$C_{\text{общ}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$



Энергия заряженного проводника и плотность энергии электрического поля



Электрическая энергия заряженного проводника

$$W = \frac{k}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i \quad q_i \begin{array}{l} \nearrow \sigma dS \\ \searrow \rho dV \end{array} \quad \sum_i \rightarrow \int$$

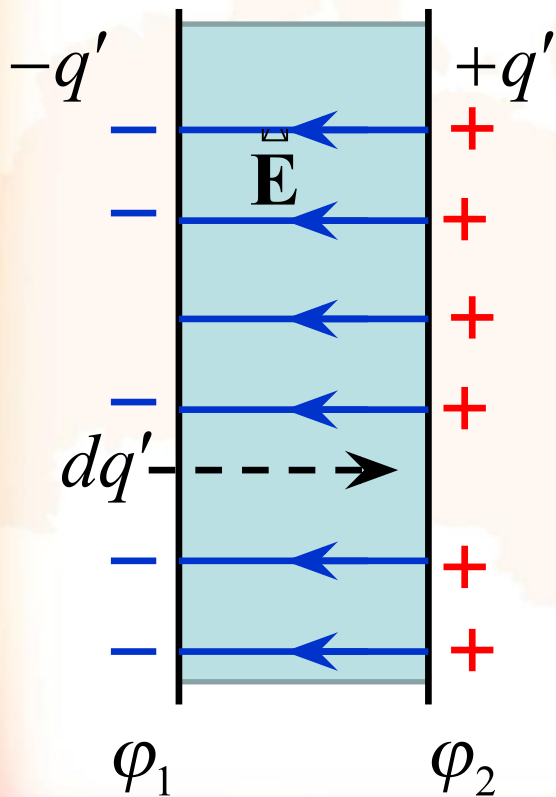
$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV + \frac{1}{2} \oint_S \sigma \varphi dS \quad \text{Проводник: } \rho = 0, \quad \varphi = \text{const}$$

$$W = \frac{1}{2} \oint_S \sigma \varphi dS = \frac{\varphi}{2} \oint_S \sigma dS = \frac{q\varphi}{2}$$

$$W = \frac{q\varphi}{2} = \frac{C\varphi^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$



Электрическая энергия заряженного конденсатора



$$A_{\text{внеш}} = \Delta W = W \quad \text{т.к.} \quad W_{\text{нач}} = 0$$

$$d'A_{\text{внеш}} = (\varphi_2 - \varphi_1) dq' = U' dq' = \frac{q' dq'}{C}$$

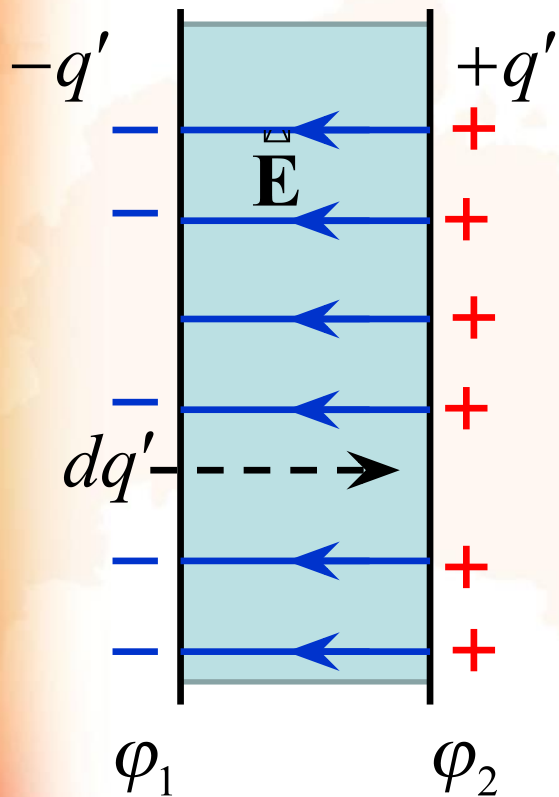
$$A_{\text{внеш}} = \frac{1}{C} \int_0^q q' dq' = \frac{q^2}{2C} = W$$

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2}$$

$$U = \varphi_2 - \varphi_1$$



Плотность энергии электрического поля



$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} \quad U = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$W = CU^2/2 = (\varepsilon\varepsilon_0 S/d)(E^2 d^2/2) = \varepsilon\varepsilon_0 SdE^2/2$$

$$\Rightarrow w = W/Sd = \varepsilon\varepsilon_0 E^2/2$$

w [Дж/м³] – плотность энергии электрического поля :

$$w = \varepsilon\varepsilon_0 E^2/2 = \mathbf{ED} / 2$$

В изотропной среде $\mathbf{D} = \varepsilon\varepsilon_0 \mathbf{E}$

В анизотропной среде $D_j = \varepsilon_0 \varepsilon_{ij} E_i$



Энергия электрического поля



Плотность энергии электрического поля. **Пример.**

$$w = \varepsilon\varepsilon_0 E^2/2$$

w [Дж/м³] – плотность энергии электрического поля :

Найдем энергию поля, создаваемого в вакууме точечным зарядом q

$$W = \int w 4\pi r^2 dr = 2\pi\varepsilon_0 \int (q/4\pi\varepsilon_0 r^2)^2 r^2 dr \Rightarrow \\ = (q^2/8\pi\varepsilon_0) \int r^{-2} dr = q^2/8\pi\varepsilon_0 r_q$$

Если $r_q \rightarrow 0$, $w \rightarrow \infty$, что нехорошо...

Версия (для электрона): $r_e = e^2/8\pi\varepsilon_0 m_e c^2 \sim 10^{-15}$ м

... оказалась тоже не очень продуктивной...



Спасибо за внимание!

**Следующая лекция
13 октября**



Пример 1. Два проводящих шарика заряжены зарядами q_1 и q_2 . Найти заряды, образующиеся на шариках, после их соединения проволокой с нулевой ёмкостью. Радиусы шариков, r_1 и r_2 , намного меньше расстояния между ними.



$$\Rightarrow q'_2 = \frac{q'_1 r_2}{r_1}$$

$$q'_1 \left(1 + \frac{r_2}{r_1} \right) = q_1 + q_2$$

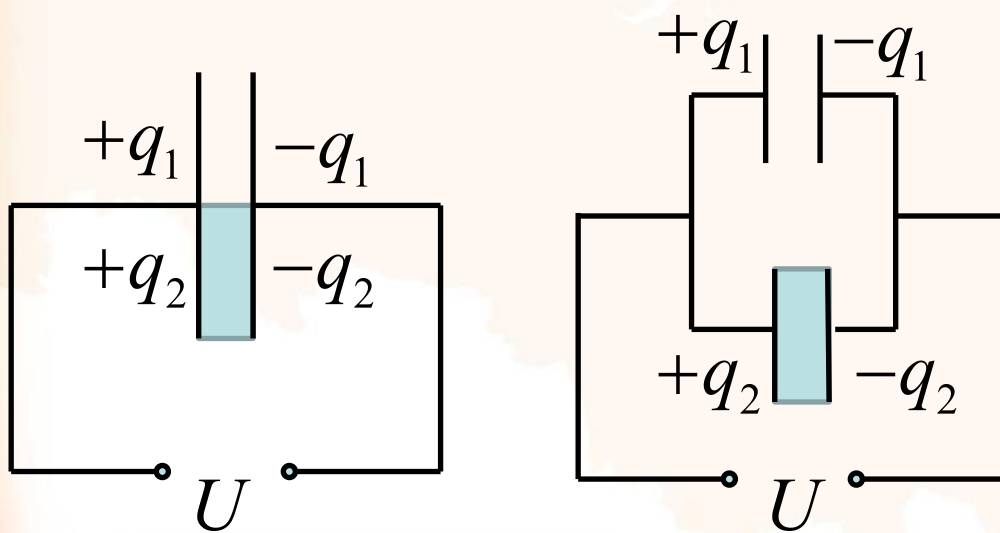
$$q'_1 + q'_2 = q_1 + q_2$$

$$\frac{q'_1}{r_1} = \frac{q'_2}{r_2}$$

$$q'_1 = \frac{(q_1 + q_2) r_1}{r_1 + r_2}$$



Пример 2. Плоский воздушный конденсатор ёмкости C_0 подключён к источнику с напряжением U . Половину пространства между обкладками конденсатора заполняют диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε . Какой заряд пройдёт через источник?



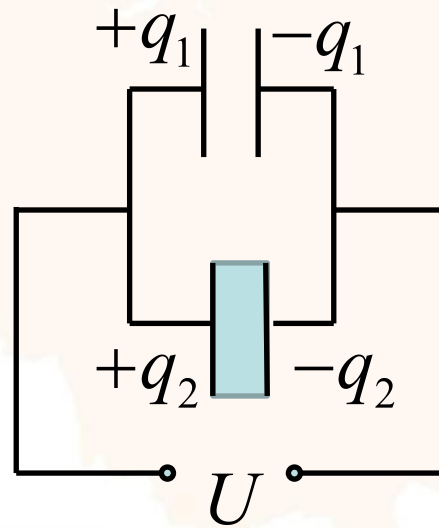
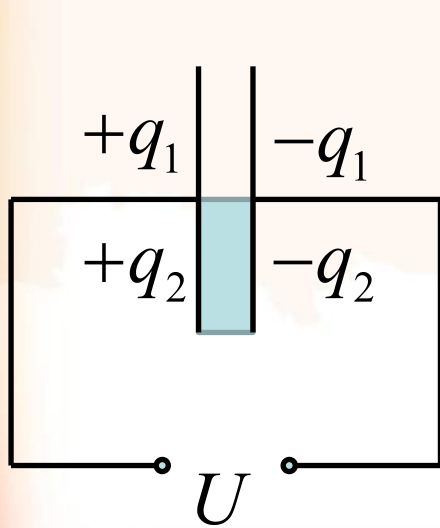
$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$$

$$C_1 = \frac{C_0}{2}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon C_0}{2}$$

$$q_1 = \frac{C_0 U}{2}, \quad q_2 = \frac{\varepsilon C_0 U}{2}$$



Пример 2. Плоский воздушный конденсатор ёмкости C_0 подключён к источнику с напряжением U . Половину пространства между обкладками конденсатора заполняют диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε . Какой заряд пройдёт через источник?



$$q_{\text{к}} = q_1 + q_2 = \frac{C_0 U (1 + \varepsilon)}{2}$$

$$q_{\text{н}} = C_0 U$$

$$\Delta q = q_{\text{к}} - q_{\text{н}} = \frac{C_0 U (\varepsilon - 1)}{2}$$



Пример 3. Используя понятие плотности электрической энергии выведите формулу для энергии заряженного плоского конденсатора.

$$D = \sigma, \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0} \quad w = \frac{\overline{\mathbf{E}\mathbf{D}}}{2} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon\epsilon_0}$$

$$W = wV = \frac{\sigma^2}{2\epsilon\epsilon_0} Sd \quad \sigma = \frac{q}{S} \Rightarrow W = \frac{q^2 d}{2S\epsilon\epsilon_0}$$

$$C = \frac{S\epsilon\epsilon_0}{d} \Rightarrow W = \frac{q^2}{2C}$$



Пример 4. В вакууме расположен шар радиуса R с диэлектрической проницаемостью ε , который равномерно заряжен с постоянной плотностью заряда ρ . Найдите зависимость плотности электрической энергии от расстояния до центра шара.

$$1). \quad r < R \quad 4\pi r^2 D_1 = \rho \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow D_1 = \frac{\rho r}{3}, \quad E_1 = \frac{\rho r}{3\varepsilon\varepsilon_0}$$

$$w_1 = \frac{E_1 D_1}{2} = \frac{\rho^2 r^2}{18\varepsilon\varepsilon_0}, \quad dV = 4\pi r^2 dr, \quad W_1 = \int_{V_1} w_1 dV$$

$$W_1 = \frac{2\pi\rho^2}{9\varepsilon\varepsilon_0} \int_0^R r^4 dr = \frac{2\pi\rho^2 R^5}{45\varepsilon\varepsilon_0}$$



$$2). \quad r > R \quad 4\pi r^2 D_2 = \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad \Rightarrow \quad D_2 = \frac{\rho R^3}{3r^2}$$

$$E_2 = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}, \quad \text{т.к. } \varepsilon = 1 \quad w_2 = \frac{E_2 D_2}{2} = \frac{\rho^2 R^6}{18\varepsilon_0 r^4}$$

$$W_2 = \int_{V_2} w_2 dV = \frac{2\pi\rho^2 R^6}{9\varepsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{2\pi\rho^2 R^5}{9\varepsilon_0}$$

$$W = W_1 + W_2 = \frac{2\pi\rho^2 R^5}{45\varepsilon\varepsilon_0} + \frac{2\pi\rho^2 R^5}{9\varepsilon_0} = \frac{2\pi\rho^2 R^5 (1 + 5\varepsilon)}{45\varepsilon\varepsilon_0}$$



Спасибо за внимание!

**Следующая лекция
13 октября**



Плотность энергии электрического поля

$$\sigma = 0 \quad \Rightarrow \quad W = \frac{1}{2} \int_{V_{\text{тела}}} \rho \varphi dV = \frac{1}{2} \int_{V_{\infty}} \rho \varphi dV,$$

$$\rho = (\nabla, \overset{\vee}{\mathbf{D}}) \quad \Rightarrow \quad W = \frac{1}{2} \int_{V_{\infty}} \varphi (\nabla, \overset{\vee}{\mathbf{D}}) dV$$

$$(\nabla, \varphi \overset{\vee}{\mathbf{D}}) = \varphi (\nabla, \overset{\vee}{\mathbf{D}}) + (\overset{\vee}{\mathbf{D}}, \nabla \varphi) \quad \Rightarrow$$

$$\varphi (\nabla, \overset{\vee}{\mathbf{D}}) = (\nabla, \varphi \overset{\vee}{\mathbf{D}}) - (\overset{\vee}{\mathbf{D}}, \nabla \varphi) \quad \Rightarrow$$



$$W = \frac{1}{2} \int_{V_\infty} \varphi (\nabla, \mathbf{D}) dV = \frac{1}{2} \int_{V_\infty} (\nabla, \varphi \mathbf{D}) dV - \frac{1}{2} \int_{V_\infty} (\mathbf{D}, \nabla \varphi) dV =$$

$$= \frac{1}{2} \oint_{S_\infty} \varphi \mathbf{D} d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_{V_\infty} \mathbf{E} \mathbf{D} dV \quad \varphi \sim \frac{1}{r} \quad D \sim \frac{1}{r^2} \quad S \sim r^2$$

$$\oint_{S_\infty} \varphi \mathbf{D} d\mathbf{S} \sim \frac{1}{r} \frac{1}{r^2} r^2 \sim \frac{1}{r} \rightarrow 0$$

($r \rightarrow \infty$)

$$W = \int_V w dV \quad w = \frac{(\mathbf{E}, \mathbf{D})}{2}$$

$$V_\infty = V \quad \mathbf{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E} \Rightarrow w = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} \quad \frac{\text{Дж}}{\text{м}^3}$$